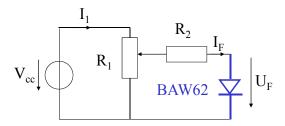
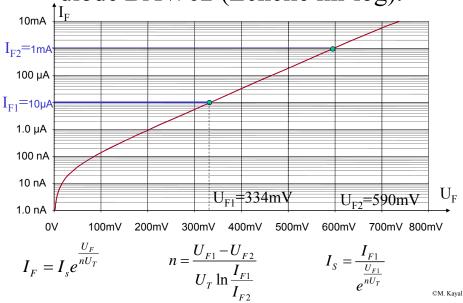
TP2-1. Caractéristique $I_F = f(U_F)$.



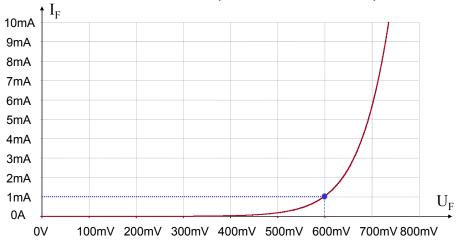
- Limitation du courant dans la diode: $R_2 = \frac{V_{cc} U_j}{I_{F,\text{max}}}$
- Contrôle aisé de I_F : $I_1 >> I_F$ ($I_1 \approx 10 \ I_F$) donc $R_1 << R_2$.
- Attention à la puissance dissipée dans \boldsymbol{R}_1 : $\boldsymbol{P}_{R1}\!\!=\!\boldsymbol{I}_1\boldsymbol{V}_{cc}\!.$

OM Vou

TP2-1. Caractéristique I_F = $f(U_F)$ de la diode BAW62 (Echelle lin-log).

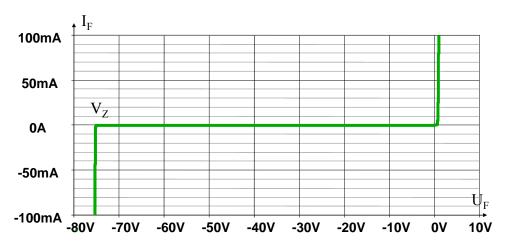


TP2-1. Caractéristique $I_F=f(U_F)$ de la diode BAW62 (Echelle lin-lin)/1.



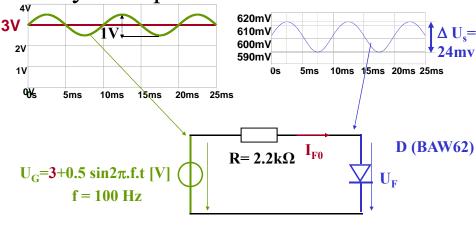
©M. Kayal

TP2-1 Caractéristique $I_F=f(U_F)$ de la diode BAW62 (Echelle lin-lin)/2.



©M. Kayal

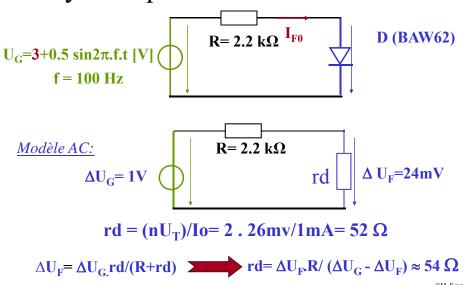
TP2-2. Mesure de la résistance dynamique de la diode BAW62



 $I_{F0} = (3V-Uj)/R = (3-0.6)/2.2k\Omega \approx 1mA$

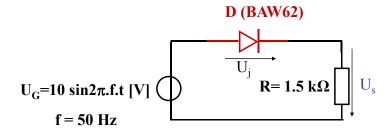
©M. Kayal

TP2-2. Mesure de la résistance dynamique de la diode BAW62



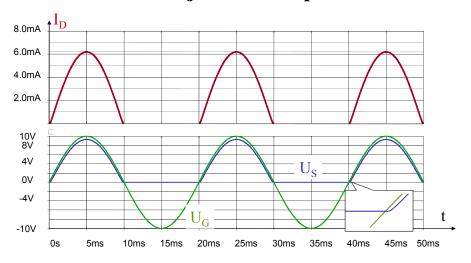
3

TP2-3. Redressement et filtrage



©M. Kayal

TP2-3. Allures des tensions et courant avant d'ajouter la capacité



©M. Kayal

TP2-3. Valeur de la capacité

$$\frac{\Delta u_{s}}{U_{s}} \approx \frac{T}{RC} = 15\% (cf : cours)$$

$$C = \frac{1}{f.R.0,15} = 88.88 \mu F$$

$$D \text{ (BAW62)}$$

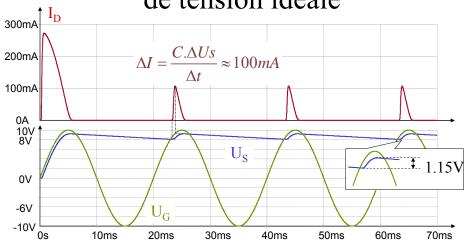
$$R = 1.5 \text{k}\Omega$$

 $U_G=10 \sin 2\pi .f.t$ [V

f = 50 Hz

©M. Kayal

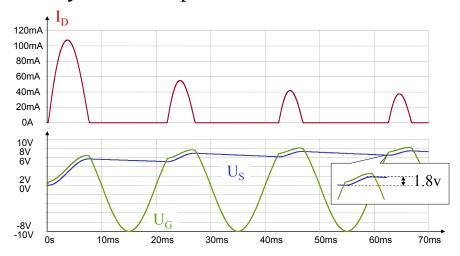
TP2-3. Mesure avec une source de tension idéale



Pour C= 88.88 μ F $\Delta u_s \approx 1.15 = 13\%.Us$

M. Kayal

TP2-3. Mesure avec une source de tension ayant une impédance interne de 50 Ω



Pour C= 88.88 μF $\Delta u_s \approx 1.8V = 25\%.U_s$ om Kayal